

SJT718A NPN型硅三极管

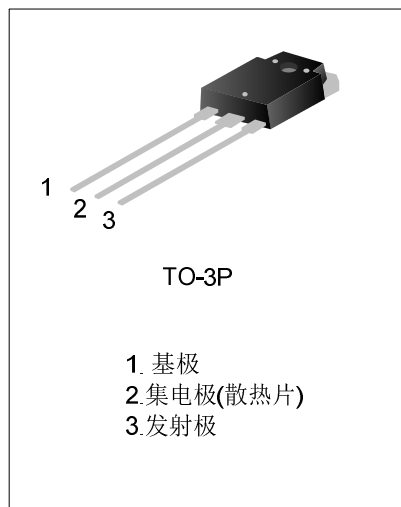
描述

SJT718ANPN NPN 型硅三极管采用士兰微电子平面三极管工艺技术制造，三重扩散、超低密度晶体缺陷、聚酰亚胺钝化、小于 200 微米的薄片等先进技术的使用使得 SJT718ANPN 具有热阻低、耗散功率大、可靠性好的特点。优化的芯片结构设计和封装设计提升了器件的抗二次击穿能力。

该产品主要应用于汽车音响等音频功率放大器的功率输出级，具有线性范围宽、失真度低的特点。

SJT718ANPN 三极管目前可提供 TO-3P 封装外形。

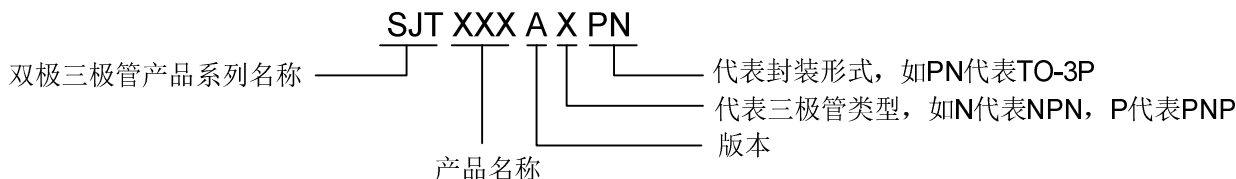
互补 PNP 管：SJT688APPN



特点

- ◆ 较高的击穿电压余量。
- ◆ 非常低的漏电电流。
- ◆ 高输出功率：80W；
- ◆ 较高的二次击穿耐量和可靠性。

产品命名规则



产品信息

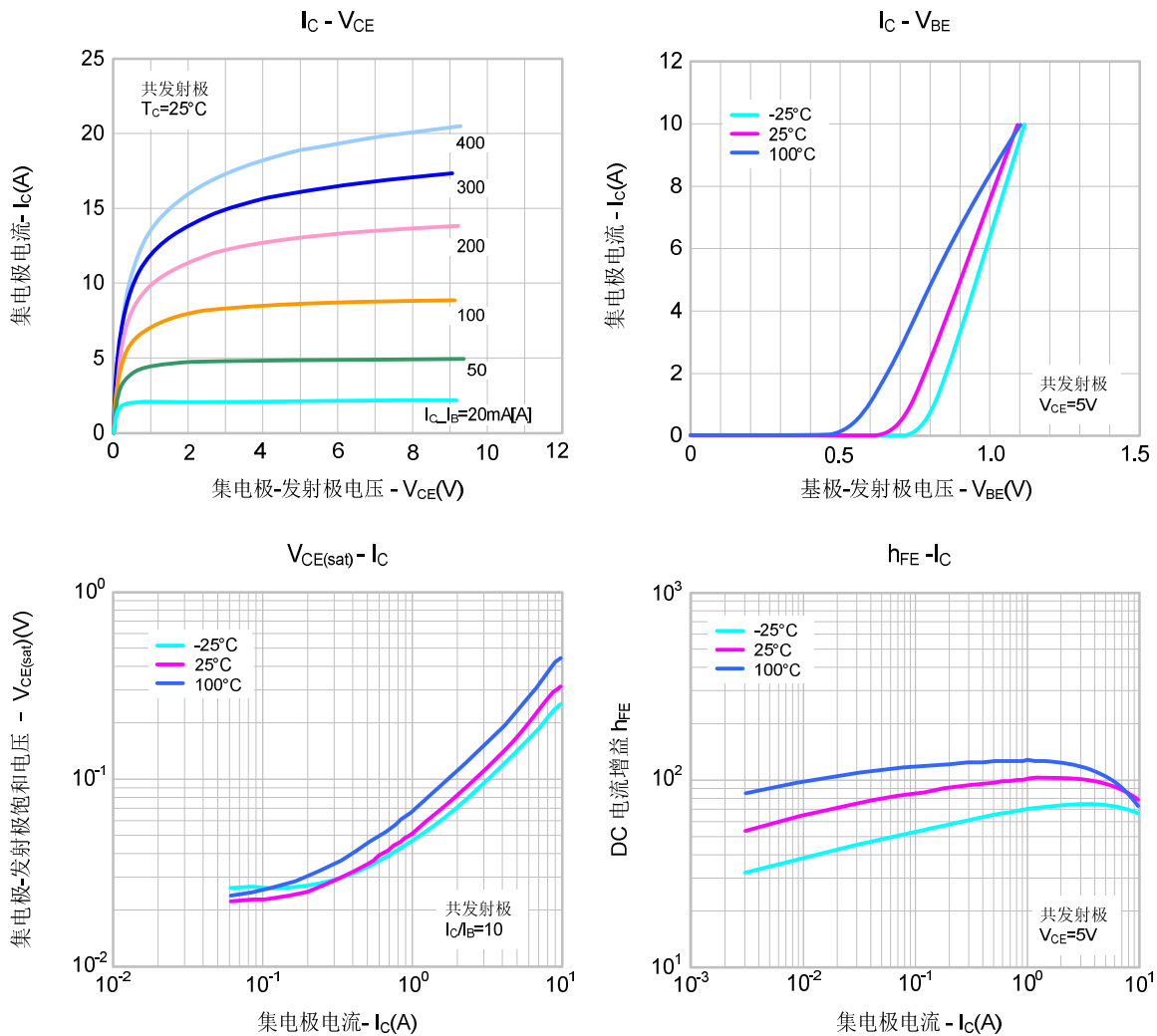
产品名称	封装形式	打印名称	材料	包装
SJT718ANPN	TO-3P	718A	无铅	料管

极限参数(除非特殊说明, $T_a=25^{\circ}\text{C}$)

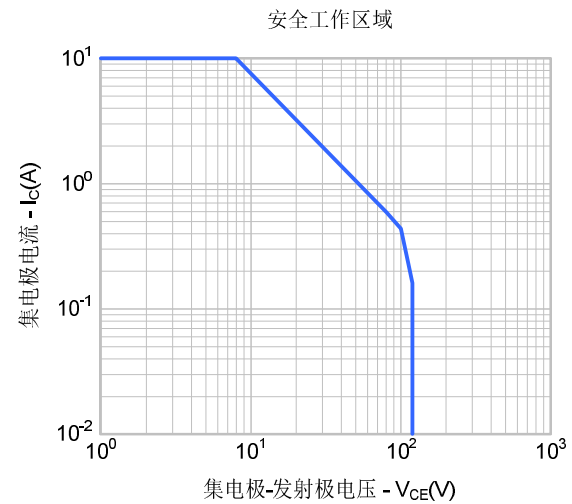
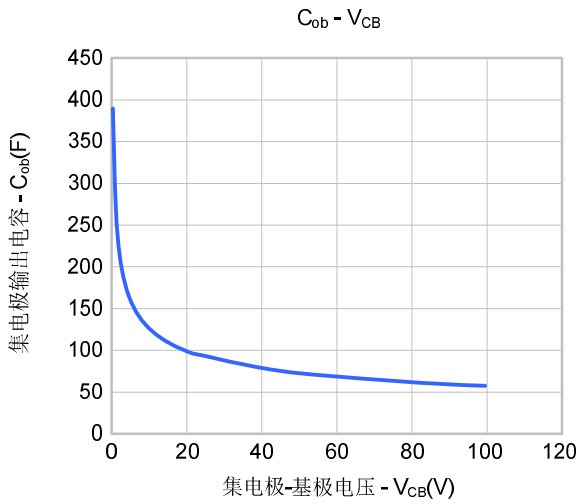
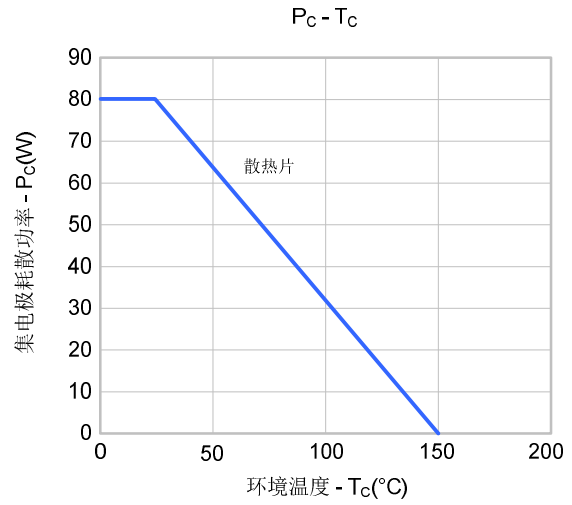
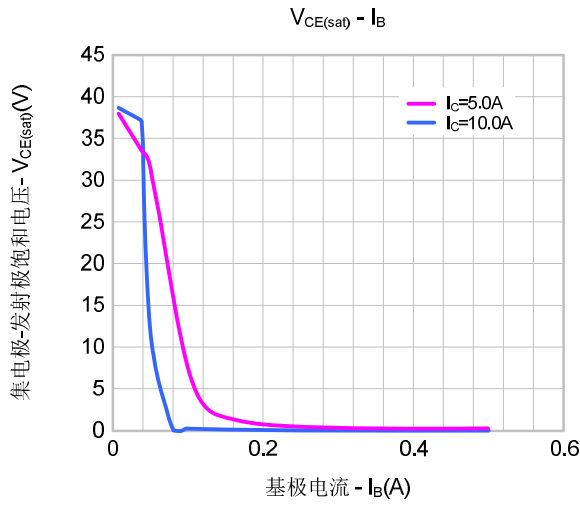
参数	符号	参数范围		单位
集电极、发射极击穿电压	BV_{CEO}	120	$I_C=5\text{mA}, I_B=0$	V
发射极、基极击穿电压	BV_{EBO}	5	$I_E=1\text{mA}, I_C=0$	V
集电极、基极击穿电压	BV_{CBO}	120	$I_C=1\text{mA}, I_E=0$	V
集电极电流	I_C	10		A
基极电流	I_B	1		A
工作结温	T_J	-55~+150		$^{\circ}\text{C}$
存储温度	T_{stg}	-55~+150		$^{\circ}\text{C}$
集电极耗散功率 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	P_C	80		W

电参数(除非特殊说明, $T_a=25^\circ\text{C}$)

参 数	符 号	测 试 条 件	最 小 值	典 型 值	最 大 值	单 位
直流电流增益	HFE	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=1\text{A}$	55	-	160	-
集电极、发射极饱和和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=6\text{A}, I_B=0.6\text{A}$	-	-	2	V
基极、发射极电压	V_{BE}	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=5\text{A}$	-	-	1.5	V
集电极、基极漏电电流	I_{CBO}	$V_{CB}=120\text{V}, I_E=0$	-	-	10	μA
集电极、发射极漏电电流	I_{CEO}	$V_{CE}=120\text{V}, I_B=0$	-	-	100	μA
发射极、基极漏电电流	I_{EBO}	$V_{EB}=5\text{V}, I_C=0$	-	-	10	μA
三极管频率	FT	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=1\text{A}$	-	12	-	MHZ
集电极输出电容	C_{Ob}	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	-	130	-	pF

典型特性曲线


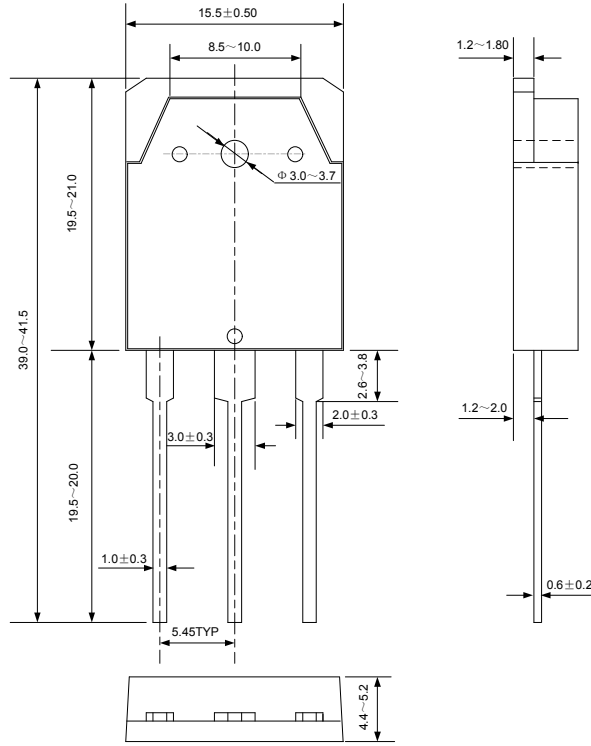
典型特性曲线 (续)



封装外形图

TO-3P

单位：毫米



声明：

- ◆ 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最新。
- ◆ 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生！
- ◆ 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！

产品名称:	SJT718ANPN	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版 本:	1.0	作 者:	殷资
------	-----	------	----

修改记录:

1. 正式发布版本
-